

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0215U000595

Державний реєстраційний номер: 0110U006262

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-03-2015

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 5

Назва етапу: Оптомеханіка наночасток, наноколоїдів, атомних та молекулярних кластерів, атомних систем.

Початок етапу: 03.2014

Закінчення етапу: 12.2014

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417302

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-12-20

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594, 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 324.5
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Оптичні, електронні та спінові явища в наноструктурах металевої, напівпровідникової та органічної природи.

Назва роботи англійською:

Optical, electronical, and spin phenomena in the nanostructures of metallic, semiconductor, and organic nature.

Реферат українською:

Запропоновано та реалізовано ефективний органічний польовий фототранзистор на основі наноструктурованого шару напівпровідникового фулерену C60. Вивчена природа фото транзисторного ефекту, який проявлявся в світлоіндукованому зсуві порогової напруги транзистора в бік від'ємних значень. Встановлено, що фоточутливість виникає лише в пристроях із верхнім положенням затвору, тобто коли діелектрик затвору (парілен) термічно наносився поверх функціонального шару C60, та вона пов'язана із появою вільних радикалів в результаті спонтанної хімічної реакції між молекулами C60 та мономерами парілену під час полімеризації. Показано, що монополярна природа зарядового транспорту в фототранзисторі на основі наноструктурованого шару фулерену C60 забезпечує підсилення фотопровідності ~2700, що є втричі вищою, ніж у кремнієвих фотодетекторів, та більш ніж в десять разів вищою, ніж максимальна величина, що опублікована до сих пір для органічних фотодетекторів. Отримана чутливість фототранзистора ~1000 A/W є втричі вищою, ніж для кремнієвих детекторів та поступається лише значенням в детекторах на основі квантових точок PbS. Результати створюють базис для реалізації високоефективних органічних фотодетекторів та елементів оптичної пам'яті.

Реферат англійською:

The efficient organic field-effect transistor based on the nanostructures layer of the C60 semiconductor fullerene is proposed and implemented. The nature of the photo-transistor effect is studied which is manifested in the light-induced shift of the threshold transistor voltage toward the negative values. It is established that the photo-sensitivity appears only in the devices with top position of the gate, i.e., when the gate dielectric (parilene) was thermally deposited over the functional layer of C60, and it is caused by appearance of the free radicals in consequence of the spontaneous chemical reaction between the C60 molecules and the parilene monomers in the course of polymerization. It is shown that the monopolar nature of the charge transport in the photo-transistor based on the nanostructured fullerene C60 layer provides amplification of photoconduction by ~2700 which three times as high than in the silicon photodetectors and ten times as large as compared to the maximal value published so far for the organic photo-detectors. The obtained photo-detector sensitivity ~1000 A/W is three times as large in regard to the silicon detectors and is worse by parameters only in regard to the detectors based on the PbS quantum dots. The results form basis for implementation of the high-efficiency organic photo-detectors and optical memory cells.

Індекс УДК: 537.311.322, 537.311.322

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Порошин Володимир Миколайович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Експериментальні дані про особливості пропускання лазерного випромінювання тонкими наноструктурованими плівками карбіду кремнію різних політипів. Результати дослідження структури нанорельєфа поверхонь тугоплавких металів і напівпровідників (Ti, W, Mo, Cu, Si, Ge, і др.), опромінених фемтосекундними лазерними імпульсами та її залежність від режиму опромінення (неперервний, сканування лазерного променя по поверхні).

Назва НТП англійською: The experimental data on the peculiarities of transmission of the laser radiation by the thin nanostructured silicon carbide films of different polytypes. The results of surface nano-relief investigations for the refractory metals and semiconductors (Ti, W, Mo, Cu, Si, Ge etc.), irradiated by the femto-second laser pulses and their dependence on the irradiation regime (continuous, laser beam scanning over the surface).

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук.

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Виявлено ефект оптичного обмеження інтенсивності наносекундних лазерних імпульсів наноструктурованими плівками карбіду кремнію. Показано, що інтенсивність обмеження залежить від довжини хвилі і для $\lambda = 532$ нм становить $I_{\text{об}} 106$ Вт/см², а для $\lambda = 1064$ нм – $I_{\text{об}} 107$ Вт/см². Встановлено тонка структура нанорельєфа поверхонь тугоплавких металів і напівпровідників, опромінених лазерними імпульсами: окрім відомої періодичної структури полос, проявляються і більш дрібні впорядковані структури в вигляді трьохмірних гранул з середнім розміром 40 нм, які включають в собі ~ 10 наночастинок з середнім розміром ~ 8 нм.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 5 років.

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади.

Перспективні ринки: Україна, країни СНД, зарубіжні країни.

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

I. I. Fishchuk, A. Kadashchuk, S. T. Hoffmann, S. Athanasopoulos, J. Genoe, H. Bessler, A. Kshler, Analytic Model of Hopping Transport in Organic Semiconductors Including both Energetic Disorder and Polaronic Contributions, AIP: Conf. Proceedings, 1610, p. 47 (2014); I. I. Fishchuk, A. Kadashchuk, S.V. Novikov, J. Genoe, N. S. Sariciftci, H. Sitter, and H. Bassler, "Origin of electric field dependence of the charge mobility and spatial energy correlations in C60-based field effect transistors", Mol. Cryst. Liq. Cryst., 589, pp. 18-28 (2014); R. Ahmed, A. Kadashchuk, C. Simbrunner, G. Schwabegger, M. Havlicek, E. Głowacki, N. S. Sariciftci, M. A. Baig, and H. Sitter, Photosensitivity of top-gate C60 based OFETs: Potential applications for high efficiency organic photodetector, Org. Electr., 15, pp. 175-181 (2014); R. Ahmed, A. Kadashchuk, C. Simbrunner, G. Schwabegger, M. A. Baig, and H. Sitter, Geometrical structure and interface dependence of bias stress induced threshold voltage shift in C60 based OFETs, ACS Applied Material and Interfaces, Vol. 6, 15148-15153, (2014).

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Яценко Леонід Петрович

Перелік осіб-виконавців

Вахнін Олександр Юрійович

Кадашук Андрій Костянтинович.

Порошин Володимир Миколайович

Фіщук Іван Іванович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

